

Micron 宣布推出 30 纳米 DDR3L-RS 产品
以支持新一代 Intel Ultrabook(TM)和超薄
计算设备

Micron 是在待机低功耗 DDR3 这一新类型产品上
获得 Intel 验证的第一家供应商

爱达荷州博伊西，2012 年 9 月 20 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 世界领先的先进半导体解决方案供应商之一 Micron Technology, Inc.（纳斯达克股票代码：MU），今日宣布推出用于超薄计算设备和平板电脑的高容量 30 纳米（nm）低功耗 DDR3L-RS SDRAM。2Gb 和 4Gb 低功耗解决方案在待机状态下提供更长的电池使用寿命的同时也保持了个人电脑 DRAM 的高性能和成本效益。

“Micron 已成为 DDR3L-RS 开发和商业化方面的领导者之一，推出 30 纳米产品证实了这一点”，IHS iSuppli 公司 DRAM 和内存首席高级分析师 Mike Howard 说到。“对于能源预算严紧同时又需要以有竞争力的价格获得高性能的用户而言，DDR3L-RS 是非常优秀的选择。我们预计大量下一代超薄平台将利用 DDR3L-RS 的优异性能”。

这些设备以前被称为“DDR3Lm”，通过减少自刷新功率（IDD6）从而全面改善系统能耗，使 Micron 能够向芯片组供应商、授权开发商和电子产品制造商提供拥有与标准 DRAM 同类性能、质量和可靠性的一流低功耗内存。DDR3L-RS 能够满足当今不断扩大的超薄计算和平板电脑市场的需要，为增强诸如 Intel Ultrabook 设备的产品特性和功能铺平了道路。

“我们的用户对这新一代 DRAM 的反馈信息极其积极”，Micron DRAM 营销副总裁 Robert Feurle 说到。“我们很高兴能成为 DRAM 解决方案的领先供应商，这使推出的超薄笔记本电脑和平板电脑更薄、运行更快、一次充电后运行时间更久。”

Micron 已实现成为第一家获得 Intel 认证的 DDR3L-RS 产品供应商的目标，这已在 Inter 网站上得到证实。

“Micron 是在使用 DDR3L-RS 的 Ivy Bridge 平台上得到验证的第一家 DRAM 供应商，为低功耗个人电脑 DRAM 设立了行业标准”，Inter 内存支持高级经理 Geof Findley 说到。

除了 2Gb 和 4Gb 设备外，Micron 已开始 8Gb x 32 DDR3L-RS 的样品开发并即将推出 8Gb x 16 DDR3L-RS 样品；预计将于 2012 年 12 月投产。这些产品通过减少主板空间和增加密度从而为系统设计提供额外的灵活性。预计在 2013 年初推出的 DDR4-RS 将能够提供额外的节能和节省空间功能。

通过这次产品发布，Micron 将凭借其广泛的 DRAM、NAND、NOR 和 SSD 解决方案组合充分支持超薄应用。欲了解更多信息，请访问 www.micron.com。

Micron Technology, Inc. 徽标位于
<http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950>

联系方式: Mary Ellen Ynes
maryellen.ynes@zenogroup.com
650-801-7954